



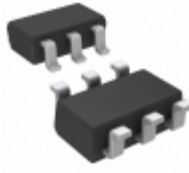




	<h2>NTGD4169FT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTGD4169FT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 2.6A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  NTGD4169FT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18578 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTGD4169FT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.6A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18578 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-25°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	900mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 2.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	295pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTGD4169FT1G ist neu im Original, Suche NTGD4169FT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTGD4169FT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTGD4169FT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTGS2012PT1G ON ON SOT323</p>	 <p>NTGD3149CT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 6-TSOP</p>	 <p>NTGS1135PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 8V 4.6A 6-TSOP</p>	 <p>NTGD4161PT1G Ault / SL Power MOSFET 2P-CH 30V 1.5A 6-TSOP</p>
 <p>NTGS1P02LT1G ON NTGS1P02LT1G ON</p>	 <p>NTGD4167CT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V 6-TSOP</p>	 <p>NTGD4161PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 1.5A 6-TSOP</p>	 <p>NTGS1P03LT1G ON NTGS1P03LT1G ON</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ AH373-WG-7	➡ AOTF454L	➡ BSiM4590	D C3216NP02W822J115AA	➡ CL10C220FB8NNWC
⚡ HVDA551QDRQ1	⚙ MCC122-12io8	D NTGD1100LT1G	➡ NTGD3122CT1G	➡ NTGD3133PT1G
⚙ NTGD3147FT1G	⚡ NTGD3148NT1G	⚙ NTGD3149CT1G	➡ NTGD4161PT1G	➡ NTGD4161PT1G
D NTGD4167CT1G	⚙ NTGD4167PT1G	⚡ NTGS1135PT1G	⚙ NTGS1N03LT1G	➡ NTGS1P02LT1G
➡ NTGS1P03LT1G	➡ NTGS3130N	⚙ NTGS3130NT1G	⚡ NTGS3136PT1G	➡ NTGS3433T1
➡ NTGS3433T1G	➡ NTGS3441BT1G	D NTGS3441LT1	⚙ NTGS3441PT1G	⚡ NTGS3441T1
⚙ NTGS3441T1G	D NTGS3441TI	➡ NTGS3442T1G	➡ NTGS3443BT1G	➡ NTGS3443T1
⚡ NTGS3443T1G	⚙ NTGS3443T2G	➡ NTGS3445T1G	➡ NTGS3446T1	➡ NTGS3446T1G
⚙ NTGS3447PT1G	⚡ NTGS3455T1G	⚙ NTGS3A033PZT1G	D NTGS4111PT1G	➡ NTGS4111PT1G.
➡ NTGS4111PT2G	⚙ NTGS4141NT1G	⚡ NTGS5120PT1G	⚙ TRS208IDWR	➡ UPC824G2

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited